

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年4月14日(14.04.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/056612 A1

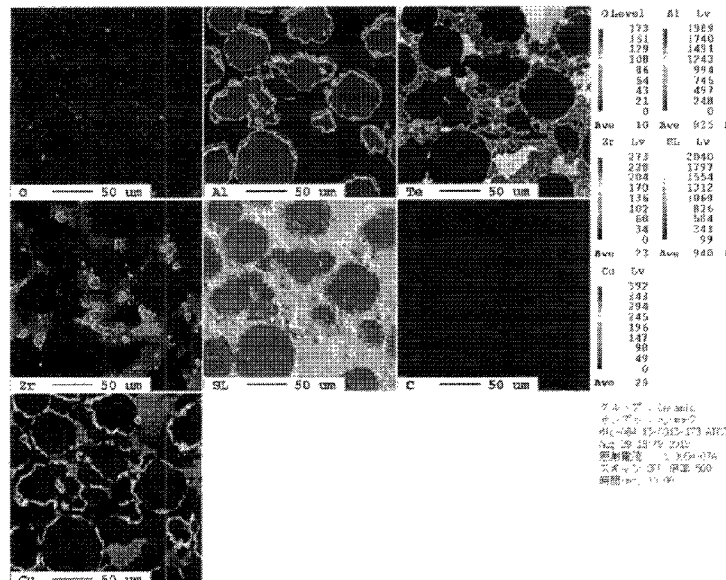
- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) C22C 1/04 (2006.01)
B22F 3/10 (2006.01) C22C 28/00 (2006.01)
B22F 3/14 (2006.01) C22C 30/00 (2006.01)
B22F 5/00 (2006.01) C22F 1/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/078564
- (22) 国際出願日: 2015年10月8日(08.10.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-207770 2014年10月9日(09.10.2014) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社(JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小井土 由将(KOIDO Yoshimasa); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 小越 勇, 外(OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門2丁目9番14号 発明会館5階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: SPUTTERING TARGET COMPRISING Al-Te-Cu-Zr-BASED ALLOY AND METHOD OF MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: Al-Te-Cu-Zr系合金からなるスパッタリングターゲット及びその製造方法

[図3]



(57) Abstract: Provided is a sputtering target characterized by containing 20-40 at% of Te, 5-15 at% of Cu, 5-15 at% of Zr, and the remainder comprising Al, and having a sputtering target structure composed of an Al phase, a Cu phase, a CuTeZr phase, a CuTe phase, and a Zr phase. The purpose of the present invention is to provide: an Al-Te-Cu-Zr-based alloy sputtering target in which degradation in properties caused by deviations in composition is effectively suppressed; and a method of manufacturing the same.

(57) 要約: Teを20at%~40at%含有し、Cuを5at%~20at%含有し、Zrを5at%~15at%含有し、残部がAlからなり、スパッタリングターゲット組織がAl相、Cu相、CuTeZr相、CuTe相及びZr相から構成されることを特徴とするスパッタリングターゲット。本発明は、組成ズレに起因する特性の劣化を効果的に抑制したAl-Te-Cu-Zr系合金スパッタリングターゲット及びその製造方法を提供することを課題とする。

WO 2016/056612 A1

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))